(19) **日本国特許庁(JP)** 

審查請求日

# (12)特 許 公 報(B1)

(11)特許番号

特許第6522182号 (P6522182)

(45) 発行日 令和1年5月29日(2019.5.29)

(24) 登録日 令和1年5月10日(2019.5.10)

FL(51) Int. CL.

G02F 1/1368 (2006, 01) GO2F 1/1368 G02F 1/1343 (2006, 01) GO2F 1/1343

> 請求項の数 7 (全 29 頁)

特願2018-28631 (P2018-28631) (21) 出願番号 (22) 出願日 平成30年2月21日 (2018.2.21)

平成30年7月18日 (2018.7.18)

シャープ株式会社

大阪府堺市堺区匠町1番地

|(74)代理人 | 110000914

||(73)特許権者 000005049

特許業務法人 安富国際特許事務所

(72) 発明者 森永 潤一

大阪府堺市堺区匠町1番地 シャープ株式

会社内

(72)発明者 吉野 光

大阪府堺市堺区匠町1番地 シャープ株式

会社内

(72) 発明者 鈴木 翔悟

大阪府堺市堺区匠町1番地 シャープ株式

会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】液晶表示装置

# (57)【特許請求の範囲】

# 【請求項1】

第一基板と、

前記第一基板に対向する第二基板と、

前記第一基板及び前記第二基板の間に挟持され、かつ、液晶分子を含む液晶層と、

複数色の絵素から各々構成される複数の画素と、を備え、

前記第一基板及び前記第二基板の少なくとも一方は、隣接する異なる色の絵素間に少なく とも配置された遮光部材を有し、

前記第一基板は、画素電極及び共通電極の一方の電極である第一の電極と、前記第一の電 極上に設けられた層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜上に設けられ、かつ、他方の電極である 第二の電極とを、前記液晶層側に向かって順に備え、

前記第二の電極には、各絵素において、スリットが設けられており、

前記スリットは、第一の方向に延びるメインスリット部と、前記メインスリット部の端部 に繋がり、かつ、第二の方向に延びるサブスリット部と、を含み、

初期配向状態の前記液晶分子の長軸及び短軸のうち、誘電率がより大きい方の軸方向と前 記第二の方向とのなす角は、前記軸方向と前記第一の方向とのなす角より大きく、

前記遮光部材が前記第一基板に設けられている場合、平面視において、前記遮光部材は、

両側の異なる色の絵素に配置された前記サブスリット部のうち、より近いサブスリット部 側で拡幅され、より遠いサブスリット部側は拡幅されず、

前記遮光部材が前記第二基板に設けられている場合、平面視において、前記遮光部材は、

20

両側の異なる色の絵素に配置された前記サブスリット部のうち、より遠いサブスリット部 側で拡幅され、より近いサブスリット部側は拡幅されないことを特徴とする液晶表示装置

## 【請求項2】

前記第一基板は、データ線を有し、

前記遮光部材は、前記データ線であることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

#### 【請求項3】

前記第一基板は、前記共通電極と接する金属配線を備え、

前記遮光部材は、前記金属配線であることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

#### 【請求項4】

前記画素電極は、前記第一の電極であり、

前記共通電極は、前記第二の電極であることを特徴とする請求項3に記載の液晶表示装置

## 【請求項5】

前記画素電極は、前記第二の電極であり、

前記共通電極は、前記第一の電極であることを特徴とする請求項3に記載の液晶表示装置

## 【請求項6】

前記第二基板は、平面視において前記遮光部材と重畳するブラックマトリクスを備え、 前記遮光部材は、平面視において、前記ブラックマトリクスが配置された領域内において 拡幅されていることを特徴とする請求項2~5のいずれかに記載の液晶表示装置。

#### 【請求項7】

前記第二基板は、ブラックマトリクスを備え、

前記遮光部材は、前記ブラックマトリクスであることを特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

### 【技術分野】

# [0001]

本発明は、液晶表示装置に関する。特に、水平配向モードの液晶表示装置に関するものである。

# 【背景技術】

### [0002]

液晶表示装置は、表示のために液晶組成物を利用する表示装置であり、その代表的な表示方式は、一対の基板間に封入された液晶組成物に対して電圧を印加し、印加した電圧に応じて液晶組成物中の液晶分子の配向状態を変化させることにより、光の透過量を制御するものである。このような液晶表示装置は、薄型、軽量及び低消費電力といった特長を活かし、幅広い分野で用いられている。

# [0003]

液晶表示装置の表示方式として、液晶分子の配向を基板面に対して平行な面内で主に回転させることによって制御を行う水平配向モードが、広視野角特性を得やすい等の理由から、注目を集めている。例えば、近年、スマートフォンやタブレット端末向けの液晶表示装置においては、水平配向モードの一種である面内スイッチング(IPS:In-Plane Switching)モードや、フリンジ電界スイッチング(FFS:FringeField Switching)モードが広く用いられている。

# [0004]

水平配向モードの液晶表示装置に関する技術として、例えば、特許文献1には、画像表示領域中に信号線、走査線及び画素電極が配列され、樹脂膜が備えられたアレイ基板と、対向基板と、これらの間に保持される液晶材料層とを含む液晶表示装置において、アレイ基板上には、画像表示領域内に、信号線を覆うように信号線に沿って延びる突条部が、樹脂膜を形成する樹脂層により一体に設けられ、突条部の頂部は、対向基板の内面から離間さ

10

20

30

40

れている液晶表示装置が開示されている。

[0005]

また、特許文献 2 には、第 1 の基板と、ゲート電極を有するゲート線と、ソース電極を有するデータ線と、ドレイン電極と、前記ゲート線と、前記データ線及び前記ドレイン電極の上に形成され、第 1 の開口部を有する有機膜と、前記有機膜の上に形成され、第 2 の開口部を有する第 1 の電極と、前記第 1 の電極の上に形成され、前記ドレイン電極を露出させるコンタクト孔を有する保護膜と、前記保護膜の上に形成される第 2 の電極と、を備え、前記ゲート電極の周縁のうち前記ゲート線と平行な第 1 の縁と、前記第 1 の電極の前記第 2 の開口部の周縁のうち前記ゲート線と平行で前記第 1 の縁と隣り合う第 2 の縁との間の直線間隔が、約 0  $\mu$ m ~ 約 6  $\mu$ m である液晶表示装置が開示されている。

10

【先行技術文献】

【特許文献】

[0006]

【特許文献1】特開2016-142943号公報

【特許文献 2 】特開 2 0 1 5 - 1 3 8 2 6 7 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0007]

図17は、比較形態の液晶表示装置に関する図であり、TFT基板とCF基板との貼り合わせにおいてCF基板が左側にずれている場合の断面模式図である。比較形態の液晶表示装置1Rは、薄膜トランジスタ(TFT:Thin Film Transistor)を有するTFT基板10Rと、カラーフィルタ(CF:Color Filter)を有するCF基板20Rと、TFT基板10R及びCF基板20Rに挟持された液晶層30Rとを備える。TFT基板10Rには、データ線131R、共通電極15R、金属配線(3rdメタル配線)18R及び画素電極17Rが設けられている。

[0008]

CF基板20Rでは、カラーフィルタ23Rの色境界に配置されたブラックマトリクス22Rが開口率確保のために細線化される場合がある。しかしながら、TFT基板10RとCF基板20Rとの貼り合わせにずれがある場合、図17の矢印で示すように斜め方向の光が通過し、斜視から意図しない色が漏れて混色となってしまうことがある。この現象を斜視混色とも言う。斜視混色は、特に、画素電極17Rに設けられたスリットの角度に影響を受ける。この点について、比較形態の液晶表示装置1Rを用いて以下に説明する。

[0009]

図18は、比較形態の液晶表示装置の平面模式図である。図19は、比較形態の液晶表示装置に関する図であり、TFT基板とCF基板との貼り合わせにおいて両基板間にずれが発生していない場合の断面模式図である。図20は、比較形態の液晶表示装置に関する図であり、TFT基板とCF基板との貼り合わせにおいて両基板間にずれが発生している場合の断面模式図である。図19及び図20は、図18におけるa-b方向に沿った3つの絵素の断面模式図であり、画素電極に設けられた後述のサブスリット部における断面模式図である。

[0010]

比較形態の液晶表示装置1Rが備えるTFT基板10Rは、複数のデータ線131R、及び、複数のデータ線131Rと交差する複数の走査線132Rを有し、スイッチング素子としてのTFTを備える。また、TFT基板10Rは、第一の絶縁基板11Rと、第一の絶縁膜12Rと、データ線131Rと、第二の絶縁膜14Rと、共通電極15Rと、層間絶縁膜16Rと、スリット171Rが設けられた画素電極17Rと、を液晶層30R側に向かって順に備える。比較形態の液晶表示装置1Rは、FFSモードの液晶表示装置である。

[0011]

画素電極17Rは、各絵素2Rに設けられており、各画素電極17Rには、互いに平行な

20

30

40

20

30

40

50

複数のスリット171Rが設けられており、各スリット171Rは、方向D1R及びD3Rにそれぞれ延びる2つのメインスリット部171aRを有する。方向D1Rに延びる各メインスリット部171aRの両端部には、方向D2Rに延びる2つのサブスリット部171aRの両端部には、方向D2Rに延びる2つのサブスリット部171aRの両端部には、方向D4Rに延びる2つのサブスリット部171bRが繋がっている。初期配向状態の液晶分子31Rの長軸311Rに対して、方向D1Rのなす角と方向D3Rのなす角は互いに等しく、同様に、方向D2Rのなす角と方向D4Rのなす角とは互いに等しい。各スリット171Rは、各画素電極17Rの中央部に配置された、方向D2Rに延びるサブスリット部171bR間の中心線に対して、線対称な形状を有する。

[0012]

液晶層30 R は、正の誘電率異方性を有する液晶分子31 R を含み、初期配向状態の液晶分子31 R の長軸311 R 及び短軸312 R のうち誘電率がより大きい方の軸(長軸311 R)方向と上記方向D2 R 又は上記方向D4 R とのなす角は、上記軸(長軸311 R)方向と上記方向D1 R 又は上記方向D3 R とのなす角より大きい。

[0013]

CF基板20Rは、第二の絶縁基板21Rと、ブラックマトリクス22R及びカラーフィルタ23Rと、オーバーコート層24Rと、を液晶層30R側に向かって順に備える。

[0014]

液晶表示装置1Rでは、1つの画素3Rが3つの絵素2Rから構成され、赤色絵素RR、緑色絵素GR及び青色絵素BRが1つの画素3Rに配置されている。以下では、緑色絵素GRが点灯状態(白制御)であり、緑色絵素GRの両隣に位置する赤色絵素RR及び青色絵素BRが非点灯状態(黒制御)である場合を例に挙げて説明する。

[0015]

比較形態の液晶表示装置1Rでは、図18に示すように、フリンジ電界を付与するために配置した画素電極17Rのスリット171Rが、垂直(紙面上)方向に対して、一定の角度をもって傾斜している。FFSモードの液晶表示装置である比較形態の液晶表示装置1Rにおいては、初期配向状態の液晶分子31Rの長軸311R(初期配向軸とも言う。)を垂直(紙面上)とし、液晶分子31Rの長軸311Rに対して、画素電極17Rに設けられたスリット171Rに角度を持たせることで、液晶分子31Rを一定方向へ回転させることができ、電圧制御によって液晶分子31Rの配向を制御することが可能となっている。なお、本比較形態では、正の誘電率異方性を有する液晶分子31Rに替えてりの誘電率異方性を有する液晶分子31Rに替えて負の誘電率異方性を有する液晶分子31Rに替えて負の誘電率異方性を有する液晶分子31Rに替えて負

[0016]

画素電極17Rは、同一絵素2R内を上下に分割してメインスリット部171aRの角度を2方位備えているので、絵素2Rの中央付近で液晶分子31Rの配向の回転方向は逆となり、絵素の中央部 X 付近では液晶分子31Rの配向衝突による乱れが生じる領域を縮小するために、絵素の中央部 X には、メインスリット部171aRより角度を更に倒したサブスリット部171bR(折れ曲がリコ)が設けられる。また、絵素の上端部 Y 及び絵素の下端部 Z においても、スリット171R端で絵素2 R の垂直方向へフリンジ電界がもたらされ、制御したい配向に対して好まれるい電界が発生する。これについても、液晶分子31Rの配向の乱れが生じる領域を縮小するために、メインスリット部171aRより角度を更に倒したサブスリット部171bRが設けられる。このように、FFSモードの液晶表示装置1Rでは、液晶分子31Rの配向が乱れることを抑えるために、絵素2 R の設計において、配向制御領域端(開口、スリット171)の上下端部および中央部等)にメインスリット部171aRと異なる角度をもつサブスリット部171bRが設けられる。なお、本明細書において、上端部及び下端部は、上下端部とも言う。

20

30

40

50

### [0017]

サブスリット部171bRは、初期配向軸(90°(垂直))とメインスリット部171aRとのなす角度よりも、初期配向軸とサブスリット部171bRとのなす角度が大きはなるように設定されている。したがって、初期配向軸(黒制御)に対する電界制御角度は、メインスリット部171aRとサブスリット部171bRとで大きく異なり、サブスリット部171bRでは僅かな電位差でも液晶分子31Rが動いてしまう。したがってフリンジ電界により液晶分子31Rが回転し易い。そのため、光を透過させることが好ましていた。サブスリット部171bRの周辺ではフリンジ電界により液晶分子31Rが回転し、光透過性を示す可能性がある。また、サブスリット部171bRが配置された領域は、上述のように液晶分子31Rの配向の乱れが生じやすい領域であり、サブスリット部171bRを設けたとしてもサブスリット部171bR近傍は液晶分子31Rの配向制御が困難な領域となる。したがって、絵素2Rの外側の領域100Rのサブスリット部171bR近傍では、液晶分子31Rの予期せぬ配向に起因する光透過の可能性もある。

### [0018]

図19に示すように、TFT基板10RとCF基板20Rとの貼り合わせにおいてずれが発生していない液晶表示装置1Rを斜め方向から観察する場合、互いに隣接する異なる色の絵素2Rのうち一方の絵素(緑色絵素GR)から他方の絵素(青色絵素BR)に向けて入射する破線矢印の光は隣接絵素2R間の領域100Rを通過するが、ブラックマトリクス22Rにより遮光されるため斜視混色は発生しない。

#### [0019]

しかしながら、図20に示すように、TFT基板10RとCF基板20Rとの貼り合わせにおいてずれが発生し、ブラックマトリクス22Rが図20において左側へとずれている液晶表示装置1Rを、緑色絵素GR対して青色絵素BR側から斜めに見た場合、緑表示が青付いて見える斜視混色が発生する場合がある。これは、点灯状態である緑色絵素GRから、非点灯状態である青色絵素BRに向けて入射する破線矢印の斜め方向の光が隣接絵素2R間の光透過性を示す領域100Rを通過した後、ブラックマトリクス22Rにより遮光されず透過し、非点灯状態の青色絵素BRから青色の光が抜けるためである。

## [0020]

以上のように、光を透過させることが好ましくない絵素 2 Rの外側の領域 1 0 0 Rにおいて、サブスリット部 1 7 1 b Rの周辺ではフリンジ電界により液晶分子 3 1 Rが回転したり、液晶分子 3 1 Rの配向乱れが発生してしまうため、黒制御されている絵素 2 Rの一部分から光が斜めに通り易くなり表示不具合(斜視混色)が発生し、表示品位の低下を招いてしまう。これは高精細画素で隣接絵素 2 R間の距離が小さくなってしまった場合、特に顕著となり、更には色境界に配置したブラックマトリクス 2 2 Rの幅が小さい場合も同様に発生し易くなる。

## [0021]

ここで、隣接絵素 2 R間の領域 1 0 0 Rにおいて液晶分子 3 1 Rを黒表示に制御することが可能である場合は、斜め方向の光が液晶層 3 0 Rによって遮断されるため、斜視混色は発生しない。例えば、隣接絵素 2 R間が充分に離れている場合、画素電極 1 7 Rと共通電極 1 5 Rとの間に発生するフリンジ電界が及ばない領域を絵素 2 R境界に設けることが可能であり、斜め方向の光は液晶層 3 0 Rで遮断され透過することができなくなる。この場合、特別な遮光対策は必要とされない。しかしながら、画素電極 1 7 Rで制御できない領域が大きくなってしまうので、透過率の低下を招いてしまう。また、画素の精細度が高まってきた場合、隣接絵素 2 R間のスペースを狭くして、透過率を確保するケースがある。この時、絵素 2 R境界の液晶分子 3 1 Rの制御は、画素制御電位の影響を強く受け、混色の懸念が高まってくる。

### [0022]

図21を用いて、斜視混色について更に説明する。図21は、比較形態の液晶表示装置の

光漏れについて説明した平面模式図である。絵素2Rの中央部と同様に、絵素2Rの端部においても、画素電極17Rと共通電極15Rとの間で発生するフリンジ電界によって液晶分子31Rが応答したり、液晶分子31Rの配向乱れが発生する。そのため、図21における二点鎖線で囲まれた外側エリア200Rでは、画素電極17R両端(画素制御端)の外部分において、光漏れが発生し得る。

## [0023]

更に、サブスリット部 1 7 1 b R 近傍の図 2 1 において丸い点線で囲まれた部分は、外側エリア 2 0 0 R からブラックマトリクス 2 2 R の隣接絵素 2 R 側の端部までの距離が特に小さく遮光量が少ない。そのため、図 2 1 において丸い点線で囲まれた部分では斜視混色のリスクが更に高まる。

# [0024]

このような斜視混色を抑えるためにブラックマトリクスを太くして遮光することも考えられるが、大幅な透過率の低下を招いてしまう。

## [0025]

ここまで、CF基板20R側に配置されるブラックマトリクス22Rが細線化される場合の斜視混色について説明した。一方、比較形態の液晶表示装置1Rが備えるTFT基板10R側では、開口率確保やクロストーク対策のために、遮光部材であるデータ線131Rが細線化されることが多い。また、一定の電位が供給される共通電極15Rを電気的に安定化させるために、共通電極15Rと直接接する層に遮光性の金属配線18Rが配置される場合があるが、この場合も同様の理由により細線化されることが多い。このように、TFT基板側に配置される遮光部材が細線化される場合も、ブラックマトリクス22Rが細線化される場合と同様の理由により斜視混色が発生し得る。

### [0026]

上記特許文献 1 によれば、遮光領域近傍において、突条部により電気力線の延び広がりが抑えられるとともに、液晶層の厚みの減少により透過率が低下するため、斜視混色をある程度抑えることはできる。しかしながら、上記突条部は透明の樹脂膜であるため光漏れを抑える効果は充分ではなく、斜視混色を抑えるには未だ改良の余地がある。また、上記特許文献 2 は、ゲート電極の周りで発生する光漏れを防ぐことを目的とするものであり、斜視混色を目的とするものではない。

# [0027]

本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、開口率の低下を抑えつつ、斜視混色を抑えることができる液晶表示装置を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

# [0028]

本発明者らは、開口率の低下を抑えつつ、斜視混色を抑えることができる液晶表示装置について種々検討した結果、第一基板及び第二基板の少なくとも一方において、隣接する異なる色の絵素間に少なくとも配置される遮光部材の形状に着目した。そして、遮光部材の側の異なる色の絵素では、一方の絵素に設けられたサブスリット部が平面視において遮光部材により近くに位置し、他方の絵素に設けられたサブスリット部が平面視において遮光部材により遠くに位置するため、基板の貼り合せずれが発生した時に遮光部材の両側で斜め方向の光の漏れ易さが異なることを見出だした。そして、光漏れが発生し易い側で遮光部材を拡幅する一方で、その反対側で遮光部材を拡幅しないことによって、斜め方向の光を効果的に遮光しつつ、開口率の低下を抑えることが可能となることを見出した。これにより、上記課題をみごとに解決することができることに想到し、本発明に到達した。

### [0029]

すなわち、本発明の一態様は、第一基板と、上記第一基板に対向する第二基板と、上記第一基板及び上記第二基板の間に挟持され、かつ、液晶分子を含む液晶層と、複数色の絵素から各々構成される複数の画素と、を備え、上記第一基板及び上記第二基板の少なくとも一方は、隣接する異なる色の絵素間に少なくとも配置された遮光部材を有し、上記第一基板は、画素電極及び共通電極の一方の電極である第一の電極と、上記第一の電極上に設け

10

20

30

40

られた層間絶縁膜と、上記層間絶縁膜上に設けられ、かつ、他方の電極である第二の電極とを、上記液晶層側に向かって順に備え、上記第二の電極には、各絵素において、スリットが設けられており、上記スリットは、第一の方向に延びるメインスリット部と、上記メインスリット部の端部に繋がり、かつ、第二の方向に延びるサブスリット部と、を含み、初期配向状態の上記液晶分子の長軸及び短軸のうち、誘電率がより大きい方の軸方向と上記第二の方向とのなす角は、上記軸方向と上記第一の方向とのなす角より大きく、上記遮光部材が上記第一基板に設けられている場合、平面視において、上記遮光部材は、両側の異なる色の絵素に配置された上記サブスリット部のうち、より遠いサブスリット部側で拡幅され、より遠いサブスリット部側で拡幅されない液晶表示装置であってもよい。

10

[0030]

上記第一基板は、データ線を有し、上記遮光部材は、上記データ線であってもよい。

[0031]

上記第一基板は、上記共通電極と接する金属配線を備え、上記遮光部材は、上記金属配線 であってもよい。

[0032]

上記画素電極は、上記第一の電極であり、上記共通電極は、上記第二の電極であってもよい。

20

[0033]

上記画素電極は、前記第二の電極であり、上記共通電極は、前記第一の電極であってもよい。

[0034]

上記第二基板は、平面視において上記遮光部材と重畳するブラックマトリクスを備え、上記遮光部材は、平面視において、上記ブラックマトリクスが配置された領域内において拡幅されていてもよい。

[0035]

上記第二基板は、プラックマトリクスを備え、上記遮光部材は、上記ブラックマトリクス であってもよい。

30

【発明の効果】

[0036]

本発明によれば、開口率の低下を抑えつつ、斜視混色を抑えることができる液晶表示装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

[0037]

【図1】実施形態1の液晶表示装置の平面模式図である。

【図2】実施形態1の液晶表示装置に関する図であり、第一基板と第二基板との貼り合わせにおいて第二基板が右側にずれている場合の、絵素の中央部における断面模式図である

40

- 【図3】実施形態1の液晶表示装置に関する図であり、第一基板と第二基板との貼り合わせにおいて第二基板が左側にずれている場合の、絵素の上端部及び下端部における断面模式図である。
- 【図4】実施形態1の液晶表示装置をカーブドディスプレイに適用した場合の模式図である。
- 【図5】実施形態2の液晶表示装置の平面模式図である。
- 【図6】実施形態3の液晶表示装置の平面模式図である。
- 【図7】実施形態4の液晶表示装置の平面模式図である。
- 【図8】実施形態5の液晶表示装置の平面模式図である。
- 【図9】実施形態5の液晶表示装置の断面模式図である。

【図10】実施形態3及び5の液晶表示装置における、斜め方向の光の遮光について説明する断面模式図である。

- 【図11】実施形態6の液晶表示装置の平面模式図である。
- 【図12】実施形態7の液晶表示装置の平面模式図である。
- 【図13】実施形態7の液晶表示装置の断面模式図である。
- 【図14】実施形態7の液晶表示装置における、斜め方向の光の遮光について説明する断面模式図である。
- 【図15】実施形態8の液晶表示装置の平面模式図である。
- 【図16】実施形態9の液晶表示装置の平面模式図である。
- 【図17】比較形態の液晶表示装置に関する図であり、TFT基板とCF基板との貼り合わせにおいてCF基板が左側にずれている場合の断面模式図である。
- 【図18】比較形態の液晶表示装置の平面模式図である。
- 【図19】比較形態の液晶表示装置に関する図であり、TFT基板とCF基板との貼り合わせにおいて両基板間にずれが発生していない場合の断面模式図である。
- 【図20】比較形態の液晶表示装置に関する図であり、TFT基板とCF基板との貼り合わせにおいて両基板間にずれが発生している場合の断面模式図である。
- 【図21】比較形態の液晶表示装置の光漏れについて説明した平面模式図である。

【発明を実施するための形態】

## [0038]

以下、本発明の実施形態について説明する。本発明は、以下の実施形態に限定されるものではなく、本発明の構成を充足する範囲内で、適宜設計変更を行うことが可能である。なお、以下の説明において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を異なる図面間で共通して用い、その繰り返しの説明は省略する。また、実施形態に記載された各構成は、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜組み合わされてもよいし、変更されてもよい。

## [0039]

# 「実施形態1]

本実施形態では、FFSモードの液晶表示装置を例に挙げて説明を行う。図1は、実施形態1の液晶表示装置の平面模式図である。図2は、実施形態1の液晶表示装置に関する図であり、第一基板と第二基板との貼り合わせにおいて第二基板が右側にずれている場合の、絵素の中央部における断面模式図である。図3は、実施形態1の液晶表示装置に関する図であり、第一基板と第二基板との貼り合わせにおいて第二基板が左側にずれている場合の、絵素の上端部及び下端部における断面模式図である。図2は、図1におけるa-b方向に沿った3つの絵素の断面模式図であり、絵素の中央部Xに配置されたサブスリット部における断面模式図であり、絵素の上端部Y及び下端部Zに配置されたサブスリット部における断面模式図である。

## [0040]

本実施形態の液晶表示装置(液晶パネルモジュール)1は、第一基板10と、第一基板10に対向する第二基板20と、第一基板10及び第二基板20の間に挟持され、かつ、液晶分子31(ネマチック液晶)を含む液晶層30と、を備える。

### [0041]

第一基板 1 0 は、複数のデータ線(ソース線) 1 3 1 、及び、複数のデータ線 1 3 1 と交差する複数の走査線 1 3 2 を有し、スイッチング素子としての薄膜トランジスタ 1 3 ( T F T : T h i n F i l m T r a n s i s t o r )を備え、T F T 基板とも言う。

# [0042]

また、第一基板10は、第一の絶縁基板11と、第一の絶縁膜12と、データ線131と、第二の絶縁膜14と、共通電極15と、層間絶縁膜16と、画素電極17とを液晶層3 0側に向かって順に備える。本実施形態では、共通電極15が上記第一の電極であり、画 素電極17が上記第二の電極である。なお、本明細書では、共通電極と画素電極との間( 20

10

30

40

第一の電極と第二の電極との間)に電圧が印加された電圧印加状態を、単に「電圧印加状態」とも言い、共通電極と画素電極との間(第一の電極と第二の電極との間)に電圧が印加されていない電圧無印加状態を、単に「電圧無印加状態」とも言う。

#### [0043]

第一基板10の液晶層30側の面には、水平配向膜(図示せず)が設けられている。第一基板10の液晶層30と反対側の面には、第一基板10側から順に第一偏光板(図示せず)及びバックライト(図示せず)が設けられている。

## [0044]

液晶層 3 0 は、正の誘電率異方性を有する液晶分子 3 1 を含み、初期配向状態の液晶分子 3 1 の長軸 3 1 1 は、図 1 の上下方向(パネル表示面の垂直方向)に設定されている。なお、本明細書では、電圧無印加状態の液晶分子を、初期配向状態の液晶分子とも言う。正の誘電率異方性を有する液晶分子は、例えば、 2 ~ 1 3 の誘電率異方性() ) を有する

# [0045]

液晶層 3 0 は、正の誘電率異方性を有する液晶分子 3 1 に替えて、負の誘電率異方性を有する液晶分子 3 1 を含んでもよい。この場合も、初期配向状態の液晶分子 3 1 の長軸 3 1 1 は、図 1 の左右方向(パネル表示面の水平方向)に設定される。負の誘電率異方性を有する液晶分子は、例えば、 - 6 ~ - 2 の誘電率異方性を有する。

#### [0046]

なお、誘電率異方性は、下記式(L)で定義される。

= (液晶分子の長軸方向の誘電率) - (液晶分子の短軸方向の誘電率) (L)

### [0047]

第二基板 2 0 は、第二の絶縁基板 2 1 と、ブラックマトリクス 2 2 及びカラーフィルタ(CF:Color Filter) 2 3 と、オーバーコート層 2 4 とを液晶層 3 0 側に向かって順に備える。第二基板 2 0 は、CF基板とも言う。ブラックマトリクス 2 2 は、隣接する絵素 2 間に配置された遮光部材である。第二基板 2 0 の液晶層 3 0 側の表面上には、水平配向膜(図示せず)が設けられている。第二基板 2 0 の液晶層 3 0 と反対側の面には、第二偏光板(図示せず)が設けられている。

## [0048]

液晶表示装置1では、1つの画素3内に3つの絵素2(赤色絵素R、緑色絵素G及び青色絵素B)が配置されている。以下では、緑色絵素Gが点灯状態(白制御)であり、緑色絵素Gの両隣に位置する赤色絵素R及び青色絵素Bが非点灯状態(黒制御)である場合を例に挙げて説明を行う。

# [0049]

第一基板10について詳細に説明する。第一基板10は、図1の垂直方向(パネル表示面の垂直方向)に延在する複数のデータ線131と、複数のデータ線131と交差し、図1の水平方向(パネル表示面の水平方向)に延在する複数の走査線132と、複数のTFT13と、を備える。複数のデータ線131はそれぞれ、隣接する絵素2間に配置された遮光部材である。

## [0050]

各TFT13は、複数のデータ線131及び複数の走査線132のうちの対応するデータ線131及び走査線132に電気的に接続され、薄膜半導体134、対応するデータ線131の一部で構成されるソース電極131a、対応する走査線132の一部で構成されるゲート電極132a、及び、複数の画素電極17のうちの対応する画素電極17と電気的に接続されたドレイン電極133aを有する三端子スイッチである。

# [0051]

互いに隣接する2本のデータ線131と、互いに隣接する2本の走査線132とに囲まれた各領域には、複数のスリット(開口)171が設けられた画素電極17が配置されている。画素電極17は半導体134を介してデータ線131と電気的に接続されており、走査線132のOn/Offの電位制御によってソース信号を画素電極17へ充電し、画素

10

20

30

40

電位を任意に制御することができる。これにより、画素電極17の下層に層間絶縁膜16介して配置された共通電極15との間でフリンジ電界を発生させ、液晶分子31を動作させ、第二基板20側で赤色絵素 R / 緑色絵素 G / 青色絵素 B に区画された絵素単位で光を透過させることでカラー表示させることが可能となっている。

## [0052]

画素電極17は、各絵素2に設けられており、各画素電極17には、互いに平行な複数のスリット171が設けられており、共通電極15は、スリット171に対向している。画素電極17及び共通電極15の間に印加される電圧を制御することによって、液晶分子31の配向、より詳細には回転を制御する。

### [0053]

画素電極 1 7 の構造について更に詳述する。スリット 1 7 1 は、各絵素 2 において、液晶分子 3 1 の短軸 3 1 2 に対して互いに線対称な形状を有する上部スリット 1 7 1 1 及び下部スリット 1 7 1 2 を有する。本実施形態の液晶表示装置 1 は、マルチドメイン(2 ドメイン)の F F S モードの液晶表示装置である。

## [0054]

上部スリット1711は、方向D1に延びるメインスリット部171aと、方向D1に延びるメインスリット部171aの両端部に繋がり、かつ、方向D2に延びる2つのサブスリット部171bと、を含む。下部スリット1712は、方向D3に延びるメインスリット部171aの両端部に繋がり、かつ、方向D4に延びる2つのサブスリット部171bと、を含む。ここで、方向D1及びD3は上記第一の方向に対応し、方向D2及びD4は上記第二の方向に対応する。各スリット171は、各画素電極17の中央部に配置された、方向D2に延びるサブスリット部171b及び方向D4に延びるサブスリット部171b及び方向D4に延びるサブスリット部171b百の中心線に対して、線対称な形状を有する。

### [0055]

初期配向状態の液晶分子 3 1 の長軸 3 1 1 及び短軸 3 1 2 のうち誘電率がより大きい方の軸方向(正の誘電率異方性を有する場合は長軸 3 1 1、負の誘電率異方性を有する場合は短軸 3 1 2 )とサブスリット部 1 7 1 b の延在方向 D 2、 D 4 (第二の方向)とのなす角は、上記誘電率がより大きい方の軸方向とメインスリット部 1 7 1 a の延在方向 D 1、 D 3 (第一の方向)とのなす角より大きい。そのため、液晶分子 3 1 は、メインスリット部 1 7 1 a 周辺よりもサブスリット部 1 7 1 b 周辺では僅かな電位差でも回転する。

## [0056]

初期配向状態の液晶分子31の長軸311及び短軸312のうち誘電率がより大きい方の軸方向とサブスリット部171bの延在方向D2、D4とのなす角(以下、単に「サブスリット部171bの角度」とも言う。)は、10°~50°であることが好ましく、20°~40°であることがより好ましい。また、上記誘電率がより大きい方の軸方向とメインスリット部171aの延在方向D1、D3とのなす角(以下、単に「メインスリット部171aの角度」とも言う。)は、1°~20°であることが好ましく、5°~15°であることがより好ましい。サブスリット部171bの角度は、メインスリット部171aの角度より、10°~45°大きいことが好ましく、15°~35°大きいことがより好ましい。

# [0057]

初期配向状態の液晶分子31の長軸311に対して、方向D1のなす角と方向D3のなす角は互いに等しく、同様に、方向D2のなす角と方向D4のなす角とは互いに等しい。各スリット171は、液晶分子31の短軸312に対して、線対称な形状を有する。

### [0058]

本実施形態の液晶表示装置1では、水平(紙面横)または垂直(紙面縦)方向に初期配向された液晶分子31が倒れる方向に迷うことが無いよう、一定の傾斜をもってメインスリット部171aのスリット角度が設定されている。また、スリット端ではフリンジ電界の

10

20

30

40

20

30

40

50

方向が液晶応答について好ましくない方向(縦方向)になってしまうので、液晶分子31の応答の安定性を確保するためにメインスリット部171aRよりもさらに角度を持ったサブスリット部171b(第一の折れ曲がり部)が形成されている。一方、絵素2の中央部では、初期配向に対する液晶分子31の動く方向が絵素2の上部と下部とで互いに反対方向となっており、絵素2の中央部において液晶分子31の配向が衝突する箇所が生じてしまう。液晶分子31の応答の安定性を確保するため、絵素2の上下端部と同様に、中央部にはメインスリット部171aよりもさらに角度を持ったサブスリット部171b(第二の折れ曲がり部)が形成されている。このように、本実施形態の液晶表示装置1は、絵素2の中央部、上端部及び下端部にサブスリット部171b(画素電極折れ曲がり部)を有する構成となっている。

[0059]

色境界に配置された第二基板 2 0 側のブラックマトリクス 2 2 に対して、第一基板 1 0 側のデータ線 1 3 1 をセンター合わせに配置することが開口率的に最も効率的な構成である。このとき、上記第一の折れ曲がり部及び第二の折れ曲がり部において、サブスリット部 1 7 1 b R がデータ線 1 3 1 に近づく方向は互いに異なる。絵素の中央部である第二の折れ曲がり部では、絵素 2 の境界に位置するデータ線 1 3 1 R が、両側の異なる色の絵素 2 に配置されたサブスリット部 1 7 1 b により近く、絵素 2 の上下端部である第一の折れ曲がり部では、左側のサブスリット部 1 7 1 b により近い。

[0060]

画素電極17と共通電極15との間でフリンジ電界を形成し、液晶分子31の応答を得る FFSモードの液晶表示装置1では、画素電極17に設けられたスリット171とデータ 線131との距離が近いほど、画素電極17のエッジが絵素2間の境界に近くなり、画素 電極17のエッジで発生するフリンジ電界が絵素2間の境界にまで及び易くなる。ここで 、上述のように、液晶分子31は、メインスリット部171a周辺よりもサブスリット部 171b周辺において回転し易いため、光を透過させることが好ましくない絵素2の外側 の領域100(絵素2の境界)においても、サブスリット部171bの周辺ではフリンジ 電界により液晶分子31が回転し易く、また、サブスリット部171bとデータ線131 との距離が近いほどこの現象は起こり易い。また、サブスリット部171bが配置された 領域は、液晶分子31の配向の乱れが生じやすい領域であり、サブスリット部171bを 設けたとしてもサブスリット部171b近傍は液晶分子31の配向制御が困難な領域とな る。したがって、絵素2の外側の領域100のサブスリット部171b近傍では、液晶分 子31の予期せぬ配向に起因する光透過の可能性もある。そのため、例えば、ある絵素が 白(全透過)で制御され、当該絵素に隣接する絵素が黒(透過させない)状況であった場 合、サブスリット部171bの周辺で斜視の混色に対する懸念が高まり、第二基板の貼り 合わせ(ブラックマトリクスの位置)が白絵素側にずれた場合、斜視混色の懸念がより高 まる。

[0061]

また、本実施形態では、サブスリット部171bがデータ線131に近づく方向が、絵素2の中央部と上下端部とで逆方向であるため、斜視混色の懸念が更に高まる状況は、絵素2の中央部と上下端とで逆方向となる。例えば、第二基板20が右側へずれる場合は、図2に示すように絵素2の中央部で斜視混色が発生する懸念がより高まり、左側へずれる場合は、図3に示すように絵素2の上下端部で斜視混色が発生する懸念がより高まる。

[0062]

本実施形態ではこれらの課題を解決するために、異なる色の絵素 2 間に配置される遮光部材 4 0 としてデータ線 1 3 1 に着目し、斜視混色発生する懸念が高まる方向にのみデータ線 1 3 1 を拡幅して追加遮光部 4 1 を配置する。より具体的には、第一基板 1 0 に設けられた遮光部材 4 0 としてのデータ線 1 3 1 は、データ線 1 3 1 の両側の異なる色の絵素 2 に配置されたサブスリット部 1 7 1 b 側で拡幅される。これにより、基板の貼り合せずれが発生した時に斜め方向の光がより漏れ易い側

で遮光部材40を拡幅し、第一基板10で斜め方向の光を遮光することが可能となり、斜視混色を抑えることができる。更に、データ線131は、データ線131の両側の異なる色の絵素2に配置されたサブスリット部171bのうち、より遠いサブスリット部171b側で拡幅されないことにより、データ線131が両側に拡幅される場合に比べて開口率の低下を抑えることができる。その結果、遮光部材40としてのデータ線131が両側に拡幅される場合に比べて開口率の低下を抑えつつ、斜視混色を抑えることができる。特に、画素電極17にスリット171が設けられた本実施形態では、スリット171より外側に画素電極17のエッジが配置されるため、スリットを設けた共通電極を画素電極上に配置する態様(後述の実施形態7及び8)と比べて、フリンジ電界が絵素2のより外側にまで広がり易く、斜視混色が発生し易いが、データ線131を上記のように拡幅させることにより、効果的に斜視混色を抑えることができる。

10

## [0063]

また、上記特許文献 1 では、突条部により液晶界面での平滑性が低下し、配向不良等の不具合が発生する場合があるが、本実施形態では上記特許文献 1 のような突条部を設けないので配向不良の発生を抑えつつ、斜視混色を抑えることができる。

[0064]

データ線131は、平面視において、データ線131の両側の異なる色の絵素2に配置されたサブスリット部171bのうち、より近いサブスリット部171b側で拡幅されればよく、拡幅される程度は特に限定されないが、開口率の低下を抑える観点から、重畳するブラックマトリクス22が配置された領域内において、例えば1~5 $\mu$  m 拡幅される(すなわち、追加遮光部41の幅を1~5 $\mu$  m とする)ことが好ましい。

20

#### [0065]

追加遮光部41を有する遮光部材40(データ線131)が拡幅されていない部分では、 遮光部材40に隣接するメインスリット171aと遮光部材40との距離は一定であるが 、遮光部材40が拡幅されている部分では、遮光部材40に隣接するスリット171とデータ線131との距離が小さくなる。すなわち、遮光部材40に隣接するメインスリット 171aと遮光部材40との距離に比べて、隣接するスリット171との距離が小さい部 分において、遮光部材40が拡幅されているものとし、隣接するスリット171との距離 が同じであるか(実質的に同じである場合を含む)、大きい部分では、遮光部材40は拡幅されていないものとする。

30

## [0066]

データ線131が拡幅される領域は、より近いサブスリット部171bを走査線132の延在方向にデータ線131上へ投影した領域の少なくとも一部であればよく、例えば、投影した領域の一部であっても、投影した領域の全てであっても、投影した領域の全てを含む更に広い領域であってもよい。

[0067]

以上、実施形態 1 における主な特徴である遮光部材 4 0 の構造について説明した。以下、その他の構造、各部材の材料及び製造方法について説明する。

[0068]

共通電極15に対しては、一定値に保たれた共通信号が供給される。共通電極15は、絵素の境界に関わらず、画素電極17とドレイン電極133aとの接続部等の特定部分を除いて、ほぼ一面に形成されている。

40

## [0069]

第一の絶縁基板11及び第二の絶縁基板21の材料としては、ガラス、プラスチック等の透明な材料が好適に用いられる。

# [0070]

第一の絶縁膜12及び層間絶縁膜16は、例えば、無機絶縁膜である。第二の絶縁膜14 は、例えば、有機絶縁膜、又は、有機絶縁膜及び無機絶縁膜の積層体である。上記無機絶 縁膜の材料としては、窒化シリコン、酸化シリコン等が挙げられる。上記有機絶縁膜の材 料としては、感光性アクリル樹脂等の透明樹脂が挙げられる。

#### [0071]

データ線131、走査線132及びTFT13を構成する各種配線及び電極は、スパッタリング法等により、銅、チタン、アルミニウム、モリブデン、タングステン等の金属、又は、それらの合金を、単層又は複数層で成膜し、続いて、フォトリソグラフィ法等でパターニングを行うことで形成することができる。これら各種配線及び電極は、同じ層に形成されるものについては、それぞれ同じ材料を用いることで製造が効率化される。

## [0072]

TFT13の半導体134は、例えば、アモルファスシリコン、ポリシリコン等からなる 高抵抗半導体層と、アモルファスシリコンにリン等の不純物をドープしたn+アモルファ スシリコン等からなる低抵抗半導体層とによって構成される。また、半導体134として 、酸化亜鉛等の酸化物半導体層を用いてもよい。

10

### [0073]

画素電極17及び共通電極15は、例えば、酸化インジウム錫(ITO)、酸化インジウム亜鉛(IZO)、酸化亜鉛(ZnO)、酸化スズ(SnO)等の透明導電材料、又は、それらの合金を、スパッタリング法等により単層又は複数層で成膜して形成した後、フォトリソグラフィ法を用いてパターニングを行うことで形成することができる。画素電極17に設けられるスリット171もまた、パターニングの際に同時に形成することができる

## [0074]

ブラックマトリクス 2 2 の材料は、遮光性を有するものである限り特に限定されないが、 黒色顔料を含有した樹脂材料、又は、遮光性を有する金属材料が好適に用いられる。ブラックマトリクス 2 2 は、例えば、黒色顔料を含む感光性樹脂を塗布して成膜し、露光及び 現像等を行うフォトリソグラフィ法により形成される。

20

#### [0075]

カラーフィルタ23の材料としては、各色に対応する光を透過する感光性樹脂(カラーレジスト)が好適に用いられる。カラーフィルタ23は、例えば、感光性樹脂を塗布して成膜し、露光及び現像等を行うフォトリソグラフィ法により形成される。

# [0076]

オーバーコート層24は、第二基板20の液晶層30側の面を平坦化するものであり、例えば、有機膜(誘電率 = 3~4)を用いることができる。オーバーコート層24は、例えば、光硬化性の樹脂を塗布し、紫外線照射及び焼成を行うことにより形成される。

30

# [0077]

上記第一偏光板及び上記第二偏光板は、いずれも吸収型偏光子であり、互いに吸収軸が直交したクロスニコルの配置関係にある。

## [0078]

上記バックライトの方式は特に限定されず、例えば、エッジライト方式、直下型方式等が 挙げられる。上記バックライトの光源の種類は特に限定されず、例えば、発光ダイオード (LED)、冷陰極管(CCFL)等が挙げられる。

## [0079]

本実施形態の液晶表示装置1における第一基板10は、複数のデータ線131に電気的に接続されるソースドライバ(図示省略)、及び、複数の走査線132に電気的に接続されるゲートドライバ(図示省略)を更に有する。ゲートドライバは、コントローラ(図示省略)による制御に基づいて、走査線132に走査信号を順次供給する。ソースドライバは、TFT13が走査信号によって電圧印加状態となるタイミングで、コントローラによる制御に基づいてデータ線131にデータ信号を供給する。画素電極17は各々、対応するTFT13を介して供給されるデータ信号に応じた電位に設定され、画素電極17と共通電極15との間でフリンジ電界が発生し、液晶層30の液晶分子が回転する。このようにして画素電極17と共通電極15との間に印加する電圧の大きさを制御し、液晶層30のリタデーションを変化させ、光の透過、不透過を制御する。

[0800]

50

また、液晶表示装置1は、第一基板10に電気的に接続されたフレキシブルプリント基板(FPC:Flexible Printed Circuit)を有する。FPCは、可撓性のプリント基板であり、信号供給源である外部(ホスト)の制御回路基板(図示省略)と第一基板10とを電気的に接続する。

### [0081]

液晶表示装置1の精細度は特に限定されないが、高精細化に伴いブラックマトリクス22が細線化される場合であっても、斜視混色を抑えることが可能であるため、高精細度(例えば、100~1000ppi)が必要な用途に好適である。なお、本明細書における精細度(ppi:pixel per inch)とは、1インチ(2.54cm)当たりに配置される画素の数である。

# [0082]

図4は、実施形態1の液晶表示装置をカーブドディスプレイに適用した場合の模式図である。本実施形態の液晶表示装置1は、図4に示すように、第一基板10及び第二基板20が湾曲変形しているカーブドディスプレイにおいても好適に用いることができる。表示面が湾曲したカーブドディスプレイでは、第一基板10及び第二基板20が湾曲変形しているが、両基板10及び20間において曲率半径に差が生じるため、第一基板10に配置された絵素構造との相対的な位置が湾曲方向にずれて斜視混色が発生する可能性が通常のフラットディスプレイの場合より高い。しかしながら、本実施形態の液晶表示装置1では、遮光部材40としてのデータ線131を特定の側に拡幅することにより、第一基板10と第二基板20との間にずれが生じる場合であっても斜視混色を抑えることが可能であるため、本実施形態の液晶表示装置1はカーブドディスプレイにおいても好適に用いることができる。

## [0083]

カーブドディスプレイに適用された場合、実施形態1の液晶表示装置1は、図4に示すように、2つのFPC135L、135Rを備え、一方のFPC135Lは第一基板10の下端部の左側に電気的に接続され、他方のFPC135Rは第一基板10の下端部の右側に電気的に接続される。

### [0084]

第一基板10上には、2つのソースドライバ131DL、131DRが実装され、一方のソースドライバ131DLは第一基板10の下端部の左側に設けられ、他方のソースドライバ131DRは第一基板10の下端部の右側に設けられる。ソースドライバ131DLは、第一基板10の左側半分に配置される複数のデータ線131と電気的に接続され、ソースドライバ131DRは、第一基板10の右側半分に配置される複数のデータ線131と電気的に接続されている。

## [0085]

第一基板 1 0 上には、 2 つのゲートドライバ 1 3 2 D L 、 1 3 2 D R が実装され、一方のゲートドライバ 1 3 2 D L は第一基板 1 0 の左端部に設けられ、他方のゲートドライバ 1 3 2 D R は第一基板 1 0 の右端部に設けられる。

# [0086]

## 「実施形態21

本実施形態では、本実施形態に特有の特徴について主に説明し、上記実施形態と重複する内容については説明を省略する。上記実施形態1では、遮光部材40として第一基板10上に設けられたデータ線131を用いるが、本実施形態では、異なる色の絵素2間に配置される遮光部材40としてブラックマトリクス22に着目し、斜視混色に対して上記実施形態1と同様な品位レベルを得るために、第二基板側のブラックマトリクスを拡幅して、追加遮光部を配置し、斜め方向の光を遮光する態様を示す。なお、ブラックマトリクス22は、同色の絵素2間にも配置される。

## [0087]

図5は、実施形態2の液晶表示装置の平面模式図である。斜視混色を招く斜め方向の光は、隣接する異なる色の絵素2のうち、一方の絵素2の第一基板10側から、他方の絵素2

10

20

30

40

の第二基板20側へ向かって進行する。そのため、隣接する異なる色の絵素2の境界を基準にして、第二基板20上で斜め方向の光が通過する位置は、第一基板10上で斜め方向の光が通過する位置とは反対側となる。したがって、第二基板20に追加遮光部41が設けられる上記実施形態1とは反対側において遮光部材40を拡幅する。すなわち、本実施形態では、第二基板20に設けられたブラックマトリクス22を、追加遮光部41を有する遮光部材40として用い、遮光部材40としてのブラックマトリクス22は、平面視において、ブラックマトリクス22の両側の異なる色の絵素2に配置されたサブスリット部171bのうち、より遠いサブスリット部171b側で拡幅される。これにより、基板の貼り合せずれが発生した時に斜め方向の光がより漏れ易い側で遮光部材40を拡幅し、第二基板20で斜め方向の光を遮光することが可能となり、斜視混色を抑えることができる。

[0088]

更に、ブラックマトリクス 2 2 は、ブラックマトリクス 2 2 の両側の異なる色の絵素 2 に配置されたサブスリット部 1 7 1 b のうち、より近いサブスリット部 1 7 1 b 側で拡幅されないことにより、ブラックマトリクス 2 2 が両側に拡幅される場合に比べて開口率の低下を抑えることができる。このように、本実施形態においても、遮光部材 4 0 としてのブラックマトリクス 2 2 が両側に拡幅される場合に比べて開口率の低下を抑えつつ斜視混色を抑えて、表示品位を確保することができる。

[0089]

図1に示すように、上記実施形態1では、第一基板10上に設けられた追加遮光部41の大部分が第二基板20上に設けられたブラックマトリクス22と重畳する位置に配置されるため、追加遮光部41を配置することによる開口率の低下は小さい。一方、本実施形態では、図5に示すように、追加遮光部41がブラックマトリクス22を用いて形成されるため、上記実施形態1に比べて、開口率は低下してしまう。

[0090]

ブラックマトリクス 2 2 は、平面視において、ブラックマトリクス 2 2 の両側の異なる色の絵素 2 に配置されたサブスリット部 1 7 1 b のうち、より遠いサブスリット部 1 7 1 b 側で拡幅されればよく、拡幅される程度は特に限定されないが、基板間のずれを考慮して、例えば 1 ~ 5 μ m 拡幅される(すなわち、追加遮光部 4 1 の幅を 1 ~ 5 μ m とする)ことが好ましい。

[0091]

ブラックマトリクス 2 2 が拡幅される領域は、より遠いサブスリット部 1 7 1 b を走査線 1 3 2 の延在方向にブラックマトリクス 2 2 上へ投影した領域の少なくとも一部であればよく、例えば、投影した領域の一部であっても、投影した領域の全てであっても、投影した領域の全てを含む更に広い領域であってもよい。

[0092]

[実施形態3]

本実施形態では、本実施形態に特有の特徴について主に説明し、上記実施形態と重複する内容については説明を省略する。上記実施形態1では、1つの絵素2内で配向方向を2方位もって、視野角を補償している構成を示した。本実施形態では、1つの絵素では1方位のメインスリット部の角度を有し、縦の2つの絵素単位で配向方向を2方位有する構成について示す。

[0093]

図6は、実施形態3の液晶表示装置の平面模式図である。本実施形態では、縦に並ぶ2つの絵素2のうち一方の絵素2に配置された画素電極17には、方向D1に延びるメインスリット部171aの両端部に繋がり、かつ、方向D2に延びる2つのサブスリット部171bと、を含むスリット171が設けられており、他方の絵素2に配置された画素電極17には、方向D3に延びるメインスリット部171aの両端部に繋がり、かつ、方向D4に延びる2つのサブスリット部171bと、を含むスリット171が設けられて

10

20

30

40

20

30

40

50

いる。初期配向状態の液晶分子31の長軸311に対して、方向D1のなす角と方向D3のなす角は互いに等しく、同様に、方向D2のなす角と方向D4のなす角とは互いに等しい。縦に並ぶ2つの絵素2に配置されたスリット171は、上記2つの絵素2の境界線に対して、線対称な形状を有する。また、縦に並ぶ2つの絵素2に配置されたスリット171は、液晶分子31の短軸312に対して、線対称な形状を有する。ここで、方向D1及びD3は上記第一の方向に対応し、方向D2及びD4は上記第二の方向に対応する。

### [0094]

本実施形態では、上述のように、液晶分子31の配向安定化を目的として、絵素の上端部 Y 及び絵素の下端部 Z において、メインスリット部171aよりも角度を倒したサブスリット部171bが設けられている。更に上記実施形態1と同様に、第一基板10に設けられた遮光部材40としてのデータ線131は、データ線131の両側の異なる色の絵素2に配置されたサブスリット部171bのうち、より近いサブスリット部171b側で拡幅される。これにより、基板の貼り合せずれが発生した時に斜め方向の光がより漏れ易い側で遮光部材40を拡幅し、第一基板10で斜め方向の光を遮光することが可能となり、斜視混色を抑えることができる。更に、データ線131は、データ線131の両側の異71b側で拡幅されないことにより、データ線131が両側に拡幅される場合に比べて開口率の低下を抑えることができる。したがって、本実施形態では、遮光部材40としてのデータ線131が両側に拡幅される場合に比べて開口率の低下を抑えつつ、斜視混色を抑えることができ、表示品位を確保することができる。

## [0095]

本実施形態では、上記実施形態1と同様の課題を解決するために、斜視から光が透過して しまう方向をフォローできるようにデータ線131に追加遮光部41を配置している。本 実施形態における追加遮光部41の位置は、1つの絵素2で見た場合、対角に備え付けら れている。

## [0096]

# 「実施形態41

本実施形態では、本実施形態に特有の特徴について主に説明し、上記実施形態と重複する内容については説明を省略する。上記実施形態 3 では、追加遮光部 4 1 を有する遮光部材 4 0 として第一基板 1 0 上に設けられたデータ線 1 3 1 を用いるが、本実施形態では、斜視混色に対して上記実施形態 3 と同様な品位レベルを得るために、第二基板側のブラックマトリクスを拡幅して、追加遮光部 4 1 を配置し、斜め方向の光を遮光する態様を示す。【0097】

図7は、実施形態4の液晶表示装置の平面模式図である。本実施形態では、第二基板20に設けられたブラックマトリクス22を、追加遮光部41を有する遮光部材40として用いる。遮光部材40としてのブラックマトリクス22は、平面視において、ブラックマトリクス22は、平面視において、ブラックマトリクス22は、平面視において、ブラックマトリクス22は、平面視において、ブラックスより遠いサブスリット部171b側で拡幅される。これにより、基板の貼り合せずれが発生した時に斜め方向の光がより漏れ易い側で遮光部材40を拡幅し、第二基板20で斜め方向の光を遮光することが可能となり、斜視混色を抑えることができる。更に、ブラックマトリクス22の両側の異なる色の絵素2に配置されたサブスリット部171b側で拡幅されないことにより、ブラックマトリクス22が両側に拡幅される場合に比べて開口率の低下を抑えることができる。このように、本実施形態においても、遮光部材40としてのブラックマトリクス22が両側に拡幅される場合に比べて開口率の低下を抑えて、表示品位を確保することができる。

### [0098]

図6に示すように、上記実施形態3では、第一基板10上に設けられた追加遮光部41の大部分が第二基板20上に設けられたブラックマトリクス22と重畳する位置に配置されるため、追加遮光部41を配置することによる開口率の低下は小さい。一方、本実施形態

では、図 7 に示すように、追加遮光部 4 1 がブラックマトリクス 2 2 を用いて形成されるため、上記実施形態 3 に比べて、開口率は低下してしまう。

### [0099]

## 「実施形態51

本実施形態では、本実施形態に特有の特徴について主に説明し、上記実施形態と重複する内容については説明を省略する。上記実施形態3では、追加遮光部41を有する遮光部材40としてデータ線131を用いるが、本実施形態では、遮光部材40として他の金属配線を用いる。

## [0100]

図8は、実施形態5の液晶表示装置の平面模式図である。図9は、実施形態5の液晶表示装置の断面模式図である。図9は、図8におけるa-b方向に沿った3つの絵素の断面模式図であり、絵素の中央部に配置されたサブスリット部における断面模式図である。

### [0101]

本実施形態の液晶表示装置1は、上記実施形態3の液晶表示装置1と同様のFFS構成画素でありながら、透明電極である共通電極15と直接接する層に金属配線(3rdメタル配線とも言う。)18が追加されている構成を示す。FFS構成の画素において基準電極となる共通電極はTFT基板側に形成されており、なおかつ画素開口部の透過率を確保するためにITOなどの透明電極にて構成されることが一般的であるが、透明導電膜は一般的に抵抗が高く、ソース信号の振幅などによって、基準電位が乱れた場合、正常電位へ充電する時間が長くなって、表示品位の低下を招くことがある。一定電位が供給されている共通電極に対して、電気的に安定化させるために低抵抗化メタル配線である3rdメタル配線によって充電能力を高める構成がある。このとき3rdメタル配線は開口部以外へ配置することが開口率を低下させることが無いという点で好ましい構成となる。図8及び図9では、データ線131及び走査線132に対応した位置(重畳する位置)に金属配線18を配置している構成を例示している。すなわち、金属配線18は、異なる色の絵素2間に配置される。

## [0102]

本実施形態では、上記実施形態3と同様に、サブスリット部171bにおいて斜視混色の 懸念が高まる。そのため、本実施形態においても、金属配線18を用いて、上記実施形態 3と同様に追加遮光部41を配置している。

## [0103]

本実施形態では、第一基板10に設けられた遮光部材40としての金属配線18は、データ線131の両側の異なる色の絵素2に配置されたサブスリット部171bのうち、より近いサブスリット部171b側で拡幅される。これにより、基板の貼り合せずれが発生した時に斜め方向の光がより漏れ易い側で遮光部材40を拡幅し、第一基板10で斜め方向の光を遮光することが可能となり、斜視混色を抑えることができる。更に、金属配線18は、データ線131の両側の異なる色の絵素2に配置されたサブスリット部171bのうち、より遠いサブスリット部171b側で拡幅されないことにより、金属配線18が両側に拡幅される場合に比べて開口率の低下を抑えることができる。したがって、本実施形態では、遮光部材40としての金属配線18が両側に拡幅される場合に比べて開口率の低下を抑えつつ、斜視混色を抑えることができ、表示品位を確保することができる。

### [0104]

本実施形態では、上記実施形態3と同様の課題を解決するために、斜視から光が透過して しまう方向をフォローできるように金属配線18に追加遮光部41を配置している。本実 施形態における追加遮光部41の位置は、1つの絵素2で見た場合、対角に備え付けられ ている。

### [0105]

図10は、実施形態3及び5の液晶表示装置における、斜め方向の光の遮光について説明する断面模式図である。図10は、図8におけるa-b方向に沿った断面を拡大した模式図である。

10

20

30

40

### [0106]

図10は、データ線131で遮光した場合と金属配線18で遮光した場合の斜視混色の遮光状況を比較するために、2種類の追加遮光部41を一つの図で示している。図10に示すように、同一角度からの光を遮蔽する効果は、液晶層30に近い側で遮光する場合により高い効果が得られる。したがって、液晶層30に近い金属配線18で遮光する本実施形態の方が、上記実施形態3に比べて遮光幅を縮小することができ、追加遮光部41の幅をより狭めることが可能であるため、開口率の低下をより抑えながら、斜視混色を抑えて表示品位を確保することができる。

## [0107]

また、データ線131で遮光した場合、データ線131の幅が一部大きくなることで、データ線131と共通電極15との間の容量など、画素表示品位確保に好ましくない寄生容量が発生し、クロストークなどの表示品位低下を生じる可能性があるが、本実施形態のように金属配線18による遮光においては、その懸念も発生しない。

## [0108]

金属配線18は、平面視において、金属配線18の両側の異なる色の絵素2に配置されたサブスリット部171bのうち、より近いサブスリット部171b側で拡幅されればよく、拡幅される程度は特に限定されないが、開口率の低下を抑える観点から、金属配線18は重畳するブラックマトリクス22が配置された領域内において、例えば1~5μm拡幅される(すなわち、追加遮光部41の幅を1~5μmとする)ことが好ましい。

## [0109]

金属配線18が拡幅される領域は、より近いサブスリット部171bを走査線132の延在方向に金属配線18上へ投影した領域の少なくとも一部であればよく、例えば、投影した領域の一部であっても、投影した領域の全てを含む更に広い領域であってもよい。

### [0110]

金属配線 1 8 は、例えば、スパッタリング法等により、銅、チタン、アルミニウム、モリブデン、タングステン等の金属、又は、それらの合金を、単層又は複数層で成膜し、続いて、フォトリソグラフィ法等でパターニングを行うことで形成することができる。

## [0111]

# 「実施形態61

本実施形態では、本実施形態に特有の特徴について主に説明し、上記実施形態と重複する内容については説明を省略する。上記実施形態 5 では、追加遮光部 4 1 を有する遮光部材 4 0 として第一基板 1 0 上に設けられた金属配線 1 8 を用いるが、本実施形態では、斜視混色に対して上記実施形態 5 と同様な品位レベルを得るために、第二基板側のブラックマトリクスを拡幅して、追加遮光部 4 1 を配置し、斜め方向の光を遮光する態様を示す。

### [0112]

図11は、実施形態6の液晶表示装置の平面模式図である。本実施形態では、第二基板20に設けられたブラックマトリクス22を、追加遮光部41を有する遮光部材40として用いる。遮光部材40としてのブラックマトリクス22は、平面視において、ブラックマトリクス22の両側の異なる色の絵素2に配置されたサブスリット部171bのうち、より遠いサブスリット部171b側で拡幅される。これにより、基板の貼り合せずれが発生した時に斜め方向の光がより漏れ易い側で遮光部材40を拡幅し、第二基板20で斜め方向の光を遮光することが可能となり、斜視混色を抑えることができる。更に、ブラックマトリクス22は、ブラックマトリクス22の両側の異なる色の絵素2に配置されたサブスリット部171b側で拡幅されないことにより、ブラックマトリクス22が両側に拡幅される場合より開口率の低下を抑えることができる。このように、本実施形態においても、遮光部材40としてのブラックマトリクス22が両側に拡幅される場合に比べて開口率の低下を抑えて、表示品位を確保することができる。

# [0113]

10

20

30

図8に示すように、上記実施形態5では、第一基板10上に設けられた追加遮光部41の大部分が第二基板20上に設けられたブラックマトリクス22と重畳する位置に配置されるため、追加遮光部41を配置することによる開口率の低下はない、又は、小さい。一方、本実施形態では、図11に示すように、追加遮光部41がブラックマトリクス22を用いて形成されるため、上記実施形態5に比べて、開口率は低下してしまう。

## [0114]

### 「実施形態71

本実施形態では、本実施形態に特有の特徴について主に説明し、上記実施形態と重複する内容については説明を省略する。上記実施形態 5 では、共通電極 1 5 の上層に配置された画素電極 1 7 にスリット 1 7 1 を設けるが、本実施形態では、共通電極と画素電極の配置を入れ替え、画素電極の上層に配置された共通電極にスリットを設ける。すなわち、本実施形態では、画素電極が第一の電極であり、共通電極が第二の電極である。

### [0115]

図12は実施形態7の液晶表示装置の平面模式図である。図13は、実施形態7の液晶表示装置の断面模式図である。図13は、図12におけるa-b方向に沿った3つの絵素の断面模式図であり、絵素の端部に配置されたサブスリット部における断面模式図である。

### [0116]

本実施形態では、液晶層 3 0 にフリンジ電界を発生させる絵素の構成例として、スリット 1 7 1 が設けられた共通電極 1 5 が上層(液晶層 3 0 側)に、層間絶縁膜を挟んで画素電極 1 7 が下層に配置される構成を示す。最上層(液晶層側)の電極にスリットが設けられていれば、FFSモードの液晶動作に対して、共通電極と画素電極とはどちらが上層側にいても特に問題はないことが一般的に知られている。

### [0117]

本実施形態では、上記実施形態5と同様に、透明電極で形成された共通電極15と同層に金属配線18を配置して低抵抗化している絵素の構成を例示している。このとき、上記実施形態5と同様に、サブスリット部171bが絵素2の境界センター(ブラックマトリクス22のセンター/データ線131のセンター)に近づいている部分に金属配線18での追加遮光部41を配置することで、斜視混色に対する対策が講じられており、この構成によると、開口率の低下なしに、表示品位を確保することができる。

# [0118]

すなわち、本実施形態では、第一基板10に設けられた遮光部材40としての金属配線18は、データ線131の両側の異なる色の絵素2に配置されたサブスリット部171bのうち、より近いサブスリット部171b側で拡幅される。これにより、基板の貼り合せずれが発生した時に斜め方向の光がより漏れ易い側で遮光部材40を拡幅し、第一基板10で斜め方向の光を遮光することが可能となり、斜視混色を抑えることができる。更に、金属配線18は、データ線131の両側の異なる色の絵素2に配置されたサブスリット部171bのうち、より遠いサブスリット部171b側で拡幅されないことにより、金属配線18が両側に拡幅される場合に比べて開口率の低下を抑えることができる。したがって、本実施形態では、遮光部材40としての金属配線18が両側に拡幅される場合に比べて開口率の低下を抑えつつ、斜視混色を抑えることができ、表示品位を確保することができる

# [0119]

本実施形態では、上記実施形態 5 と同様の課題を解決するために、斜視から光が透過して しまう方向をフォローできるように金属配線 1 8 に追加遮光部 4 1 を配置している。本実 施形態における追加遮光部 4 1 の位置は、1 つの絵素 2 で見た場合、対角に備え付けられ ている。

### [0120]

図14は、実施形態7の液晶表示装置における、斜め方向の光の遮光について説明する断面模式図である。画素電極17が共通電極15よりも液晶層30側に配置される場合に、 共通電極15と接する金属配線18で遮光する態様(実施形態5)と、共通電極15が画 10

20

30

40

20

30

40

50

素電極 1 7 よりも液晶層 3 0 側に配置される場合に、共通電極 1 5 と接する金属配線 1 8 で遮光する態様(実施形態 7 )とについて、斜視混色の遮光状況を比較するために、図 1 4 の実施形態 7 の断面模式図において、実施形態 5 の遮光部材 4 0 である金属配線 1 8 が配置される場所を仮想的に破線で示している。

## [0121]

図14に示すように、同一角度からの光を遮蔽する効果は、液晶層30に近い側で遮光する場合により高い効果が得られる。したがって、液晶層30に近い金属配線18で遮光する本実施形態の方が、上記実施形態5に比べて遮光幅を縮小することができ、追加遮光部41の幅をより狭めることが可能であるため、開口率の低下をより抑えながら、斜視混色を抑えて表示品位を確保することができる。

### [0122]

また、データ線131で遮光した場合、データ線131の幅が一部大きくなることで、データ線131と共通電極15との間の容量など、画素表示品位確保に好ましくない寄生容量が発生し、クロストークなどの表示品位低下を生じる可能性があるが、本実施形態5と同様に、本実施形態のように金属配線18による遮光においては、その懸念も発生しない

## [0123]

# 「実施形態81

本実施形態では、本実施形態に特有の特徴について主に説明し、上記実施形態と重複する内容については説明を省略する。上記実施形態 7 では、追加遮光部 4 1 を有する遮光部材 4 0 として第一基板 1 0 上に設けられた金属配線 1 8 を用いるが、本実施形態では、斜視混色に対して上記実施形態 7 と同様な品位レベルを得るために、第二基板側のブラックマトリクスを拡幅して、追加遮光部 4 1 を配置し、斜め方向の光を遮光する態様を示す。

### [0124]

図15は、実施形態8の液晶表示装置の平面模式図である。本実施形態では、第二基板20に設けられたブラックマトリクス22を遮光部材40として用いる。遮光部材40としてのブラックマトリクス22は、平面視において、ブラックマトリクス22の両側の異なる色の絵素2に配置されたサブスリット部171bのうち、より遠いサブスリット部171bのうち、より遠いサブスリット部171bのうち、より遠いサブスリット部171b側で拡幅される。これにより、基板の貼り合せずれが発生した時に斜め方向の光が可り漏れ易い側で遮光部材40を拡幅し、第二基板20で斜め方向の光を遮光することが可能となり、斜視混色を抑えることができる。更に、ブラックマトリクス22は、ブラックマトリクス22は、ブラックマトリクス22に配置されたサブスリット部171bの合ちにより、ブラックマトリクス22が両側に拡幅される場合に比べて開口率の低下を抑えることができる。このように、本場合に比べて開口率の低下を抑えて、表示品位を確保することができる。

## [0125]

図11に示すように、上記実施形態7では、第一基板10上に設けられた追加遮光部41の大部分が第二基板20上に設けられたブラックマトリクス22と重畳する位置に配置されるため、追加遮光部41を配置することによる開口率の低下はない、又は、小さい。一方、本実施形態では、図15に示すように、追加遮光部41がブラックマトリクス22を用いて形成されるため、上記実施形態7に比べて、開口率は低下してしまう。

# [0126]

## 「実施形態91

本実施形態では、本実施形態に特有の特徴について主に説明し、上記実施形態と重複する 内容については説明を省略する。本実施形態は、データ線131の形状が異なること以外 は、上記実施形態1と同様の構成を有する。

## [0127]

図16は、実施形態9の液晶表示装置の平面模式図である。上記実施形態1では、画素電

極17のスリット171がV字状となっている部分において、データ線131の形状を調 整せずに、ブラックマトリクス22のセンターに合わせてデータ線131を設計するが、 本実施形態では、画素電極17のスリット171がV字状となっている部分において、画 素電極17のスリット171の形状に沿うようにデータ線131をV字状に屈曲させる。

本実施形態では、上述のように、液晶分子31の配向安定化を目的として、絵素の中央部 X、 絵素の上端部 Y 及び絵素の下端部 Z において、メインスリット部 1 7 1 a よりも角度 を倒したサブスリット部171bが設けられている。更に上記実施形態1と同様に、第一 基板10に設けられた遮光部材40としてのデータ線131は、データ線131の両側の 異なる色の絵素2に配置されたサブスリット部171bのうち、より近いサブスリット部 171b側で拡幅される。これにより、基板の貼り合せずれが発生した時に斜め方向の光 がより漏れ易い側で遮光部材40を拡幅し、第一基板10で斜め方向の光を遮光すること が可能となり、斜視混色を抑えることができる。更に、データ線131は、データ線13 1の両側の異なる色の絵素 2 に配置されたサブスリット部 1 7 1 b のうち、より遠いサブ スリット部171b側で拡幅されないことにより、データ線131が両側に拡幅される場 合に比べて開口率の低下を抑えることができる。したがって、本実施形態では、遮光部材 40としてのデータ線131が両側に拡幅される場合に比べて開口率の低下を抑えつつ、 斜視混色を抑えることができ、表示品位を確保することができる。

[0129]

[0128]

画素電極17のスリット171のV字部に沿わせてデータ線131を設ける本実施形態の 液晶表示装置1は、画素電極17のスリット171のV字部に沿わせず、ブラックマトリ クス22のセンターに合わせてデータ線131を設計する実施形態1の液晶表示装置1に 比べ、平面視において、遮光性の部材が配置される領域が広くなる可能性があるため、高 開口率化の観点からは、実施形態9より実施形態1の液晶表示装置1の方が好ましい態様 であると言える。

## 【符号の説明】

# [0130]

1、1R:液晶表示装置

2、2R:絵素

3 、 3 R : 画素

10:第一基板(TFT基板)

10R:TFT基板

11、11R:第一の絶縁基板

12、12R:第一の絶縁膜

13:薄膜トランジスタ(TFT)

14、14R:第二の絶縁膜

15、15R:共通電極

16、16R:層間絶縁膜

17、17R:画素電極

18、18R:金属配線

20:第二基板(CF基板)

2 0 R: CF基板

21、21R:第二の絶縁基板

2 2 、 2 2 R : ブラックマトリクス

23、23R:カラーフィルタ

2 4 、 2 4 R : オーバーコート層

30、30R:液晶層

3 1 、 3 1 R:液晶分子

40:遮光部材 4 1 : 追加遮光部 20

10

30

40

100、100R:領域

131、131R:データ線

131a:ソース電極

131DL、131DR: ソースドライバ

132、132R:走查線

132DL、132DR: ゲートドライバ

132a:ゲート電極

133a:ドレイン電極

1 3 4 : 薄膜半導体

135 L、135 R: フレキシブルプリント基板(FPC)

10

140:液晶パネル

171、171R: スリット

1 7 1 a 、 1 7 1 a R : メインスリット部 1 7 1 b 、 1 7 1 b R : サブスリット部

 2 0 0 R: 外側エリア

 3 1 1、3 1 R: 長軸

 3 1 2、3 1 2 R: 短軸

 1 7 1 1: 上部スリット

 1 7 1 2: 下部スリット

B、BR:青色絵素

D1、D2、D3、D4、D1R、D2R、D3R、D4R:方向

G、GR:緑色絵素 R、RR:赤色絵素 X:絵素の中央部 Y:絵素の上端部 Z:絵素の下端部

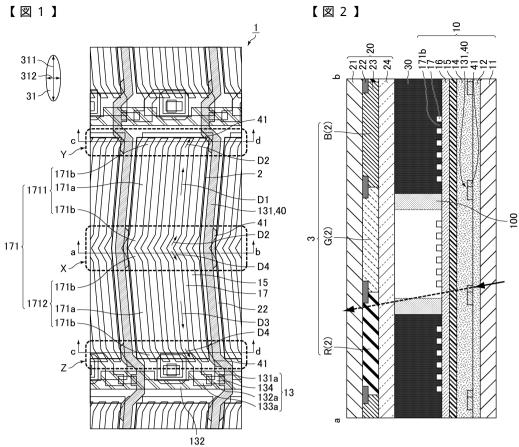
## 【要約】

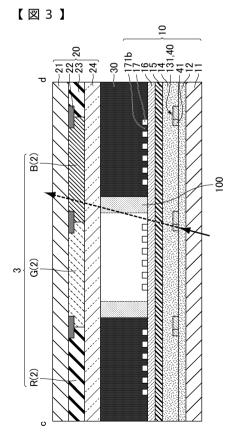
【課題】開口率の低下を抑えつつ、斜視混色を抑えることができる液晶表示装置を提供す る。

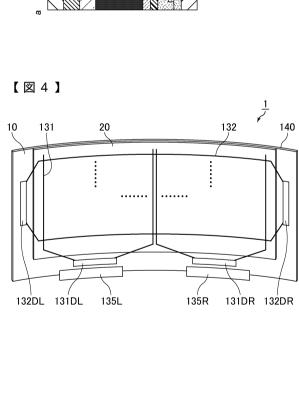
【解決手段】第一基板と液晶層と第二基板とを順に備え、上記第一基板及び上記第二基板の少なくとも一方は隣接する異なる色の絵素間に遮光部材を有し、上記第一基板はスリットが設けられた第二の電極を備え、上記スリットは第一の方向に延びるメインスリット部と第二の方向に延びるサブスリット部とを含み、初期配向状態の液晶分子の長軸及び短軸のうち誘電率がより大きい方の軸方向と上記第二の方向とのなす角は、上記軸方向と上記第一の方向とのなす角より大きく、上記遮光部材が上記第一基板上にある場合、上記遮光部材が上記第一基板上にある場合、上記遮光部材が上記第二基板上にある場合、上記第一基板の場合とは逆側に拡幅される液晶表示装置。

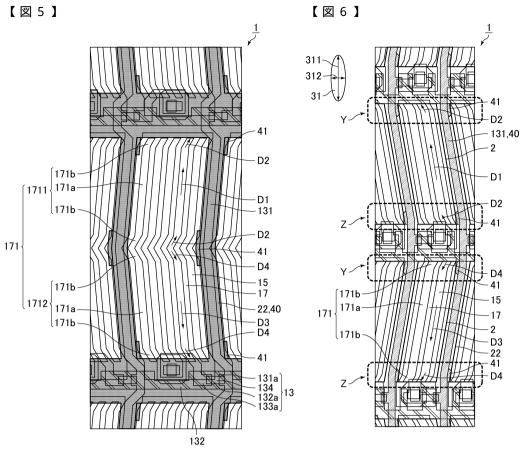
【選択図】 図1

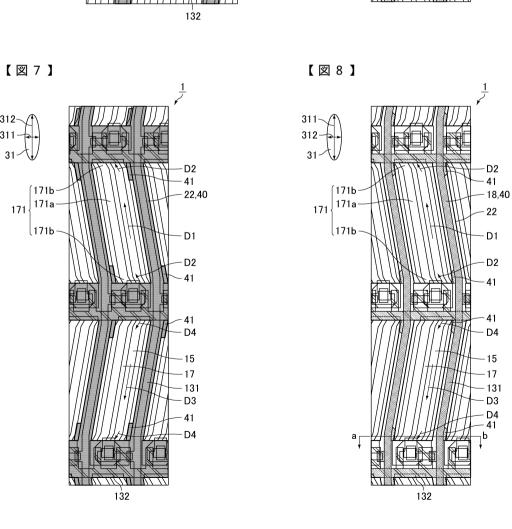
20

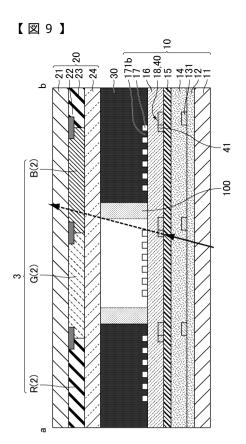


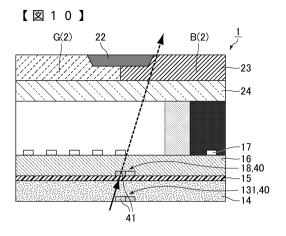


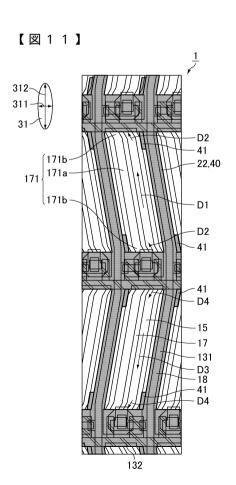


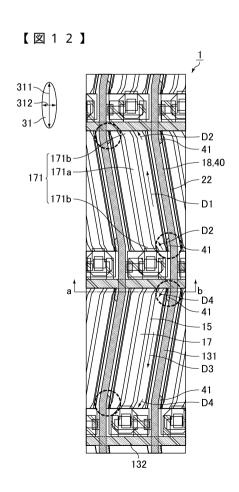


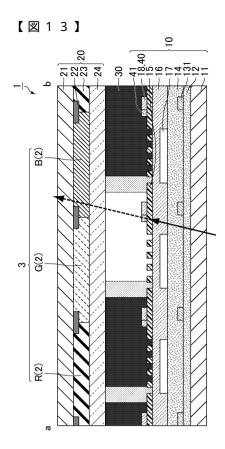


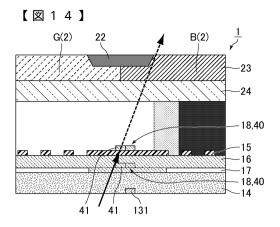


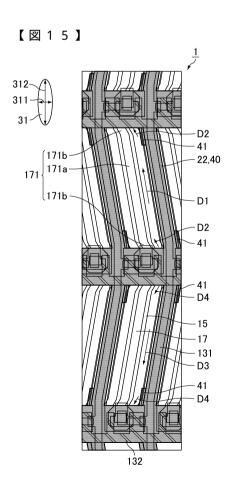


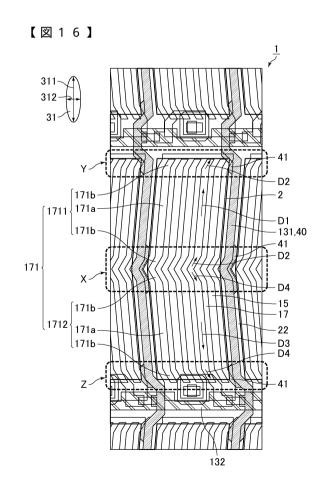












【図 1 7 】

1R

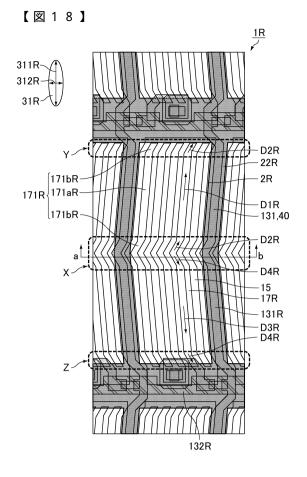
22R

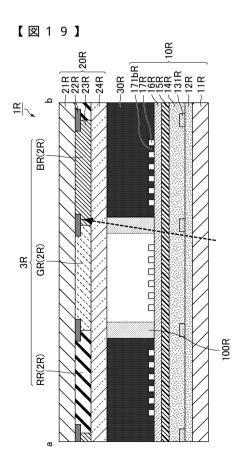
23R

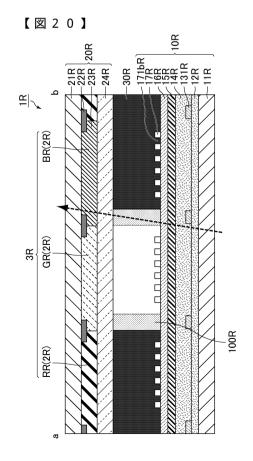
20R

30R

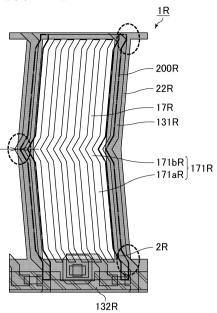
17R
18R
15R
15R
10R







【図21】



# フロントページの続き

# 審査官 越河 勉

# (56)参考文献 国際公開第2017/126438(WO,A1)

特開2014-146031(JP,A)

米国特許出願公開第2014/0362322(US,A1)

特開2001-051295(JP,A)

特開2018-205587(JP,A)

特開2016-024304(JP,A)

米国特許出願公開第2014/0211133(US,A1)

米国特許出願公開第2016/0018708(US,A1)

# (58)調査した分野(Int.CI., DB名)

G02F 1/136-1/1368

G02F 1/1343-1/1345

G02F 1/135